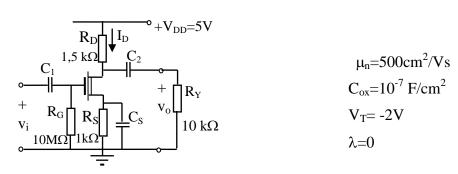
2015-1016 Bahar Dönemi ELEKTRONIK II

Ödev-2

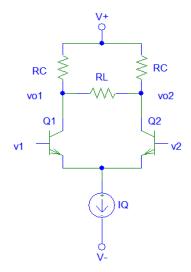
Teslim tarihi: 18.03.2016

1.



- a) Yukarıdaki devrede I_D=1mA akması için doymalı kanal ayarlamalı MOS'un (W/L) oranını hesaplayınız.
- b) Devrenin orta frekanslar bölgesindeki v_o/v_i gerilim kazancını hesaplayınız.
- c) MOSFET'i doymasız bölge sınırına getiren R_D değerini hesaplayınız.
- d) Bu devrenin DC ve AC yük doğrularını (i_D-v_{DS}) eksen takımı üzerinde gösteriniz.

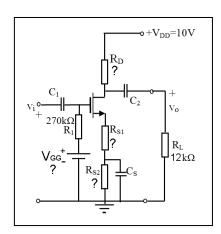
2.

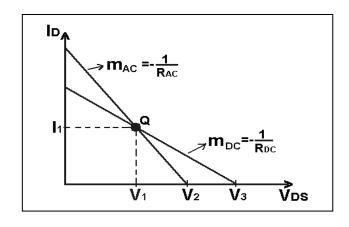


Şekildeki devrede kullanılan bütün transistorlar birbirinin eşidir. Transistor parametreleri β =200, I_S =10⁻¹⁵A, V_T =26mV alınacaktır.

- a) $K_{dd}=(v_{o1}-v_{o2})/(v_1-v_2)$ fark işaret kazancına ait bağıntıyı çıkartınız.
- b) V+=5V ve V- = -5V, I_Q =2mA, R_C =2k Ω ve R_L =3k Ω dur. Devrenin K_{dd} =(v_{o1} - v_{o2})/(v_1 - v_2) fark işaret kazancını hesaplayınız.
- c) Devrenin çıkışlarından birine bir ortak emetörlü katı nasıl bağlarsınız? Gösteriniz.

3.





Yukarıdaki NMOS CS kuvvetlendiriciye ait DC ve AC yük doğruları yanındaki şekilde verilmektedir. NMOS'un parametreleri V_{Th} =1,1 ve β =2mA/V² olarak verilmektedir. NMOS'da gövde etkisi ve kanal modülasyon katsayısı ihmal edilecektir.

- a) Devrede kutuplama akımı I_{DQ} =1mA, MOSFET üzerinde harcanan DC güç 5.4mW, ac gerilim kazancı vo/vi=-3.75, çıkış gerilimi vo'nun simetrik dalgalılığı ±3V olsun istenmektedir. V_{GG} kaynağının, R_D , R_{S1} ve R_{S2} dirençlerinin değerini bulunuz.
- b) Yük doğrularının bulunduğu şekil üzerindeki V₁, V₂, V₃ ve I₁ değerini belirtiniz.

Simetrik dalgalılık için $vd_{max} = I_{DQ}R_d$ ac durumda $vd/vi = -gmR_d/(1+gmR_s)$ DC durumda $P_{MOS} = V_{DSQ}I_{DQ}$ Doymada $I_D = (\beta/2)(V_{GS} - V_{Th})^2$

e-posta ile gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Soru çözümleri ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Kullanılan değişkenler ve birimler standart olmalıdır. Sadece sonuç içeren, çok kısa çözümler puanlandırılmayacaktır. Birimlere dikkat etmeyi unutmayınız.